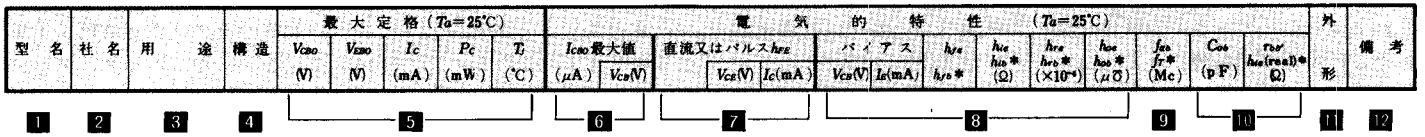
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}C_c$ $h_{ie(real)}$* (Ω)		
	2SA683	松下	PA	Si. EP	−30	−5	−1A	750	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	165	
	〃 684	〃	〃	〃	−60	−5	−1A	750	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	165	
★	〃 685	〃	AF	Si. TP	−150	−5	−50	300	125	−1	−100	150	−3	−15	−10	3	67	540	0.4	77	100*	5	35	138	
	〃 686																								
	〃 687																								
	〃 688																								
	〃 689																								
	〃 690																								
	〃 691																								
	〃 692																								
	〃 693																								
	〃 694																								
	〃 695	三菱	RF. PA	Si. EP	−25	−4	−700	500	125	−1	−25	100	−1	−500	−6	10					150*	20	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SC1209 とコンプリ
	〃 696	〃	〃	〃	−45	−4	−300	500	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SC1210 とコンプリ
	〃 697	〃	〃	〃	−65	−4	−300	500	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138B	2SC1211 とコンプリ
★	〃 698	〃	PA. SW	〃	−130	−5	−800	7W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300			t_{on}<200nS, t_{off}<800nS t_{stg}<600nS							132	
	〃 699	松下	PA	〃	−40	−5	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	50	3.3*	161	2SC1226 とコンプリ
★	〃 700	日立	〃	Si. E	−35		−1.5A	8W (Tc=25°C)	150	−10	−35	100	−2	−200	−4	500					11*	200	6*	268	
★	〃 701	三洋	RF. LN	Si. EP	−30	−5	−50	100	125	−1	−25	200	−6	−1	−6	1		2200	0.5	7	80*	12	$C_c r_{bb'}$ 100pS	27	
★	〃 702	〃	〃	〃	−50	−5	−50	100	125	−1	−45	200	−6	−1	−6	1		2200	0.5	7	80*	12	$C_c r_{bb'}$ 100pS	27	
★	〃 703	三菱	SW. PA	〃	−25	−5	−1.5A	7W (Tc=25°C)	150	−1	−16	100	−4	−500				t_{on}<0.2μS, t_{off}<0.8μS t_{stg}<0.6μS						132	2SC1243 とコンプリ
	〃 704	ソニー	RF. AF. LN SW	Si. EMe	−25	−5	−200	250	100	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	1		6600	0.76	16.2	h_{fe}=3dB (100MHz) 6		$C_c r_{bb'}$ 60pS	38	2SC631A とコンプリ
	〃 705	〃	〃	Si. E	−50	−5	−200	320	120	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	1		h_{fe}=3dB (f=100MHz)			140*	6	$C_c r_{bb'}$ 60pS	38	2SC632A とコンプリ
	〃 706	〃	RF	Si. DB	−60	−6	−1A	950	120	−1	−50	150	−2	−100	−10	10					120*	10	$C_c r_{bb'}$ 150pS	174	
★	〃 707	日電	RF. PA	Si. E	−40	−5	−500	750	135	−0.2	−25	120	−1	−100	−3	50					180*	24	10	45	2SD336 とコンプリ
	〃 708	〃	RF. AF. SW	〃	−80	−8	−700	800	150	−0.1	−60	150	−2	−50	−10	50					100*	25	25*	84B	
	〃 709	〃	〃	〃	−60	−8	−200	300	150	−0.1	−40	160	−1	−10	−10	10					280*	7.5	70*	304	
	〃 710	〃	RF. SW	〃	−50	−5	−100	300	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_{on}<80nS, t_{off}<180nS t_{stg}<140nS				600*	2.5	34*	49C	
	〃 711	〃	〃	〃	−50	−5	−100	300	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_{on}<70nS, t_{off}<170nS t_{stg}<130nS				1000*	2.5	34*	49C	
	〃 712	〃	〃	〃	−150	−5	−500	750	175	−0.1	−100	110	−10	−50	−10	50					350*	5.5	11*	84B	2SC1217 とコンプリ